

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005 年 6 月 16 日 (16.06.2005)

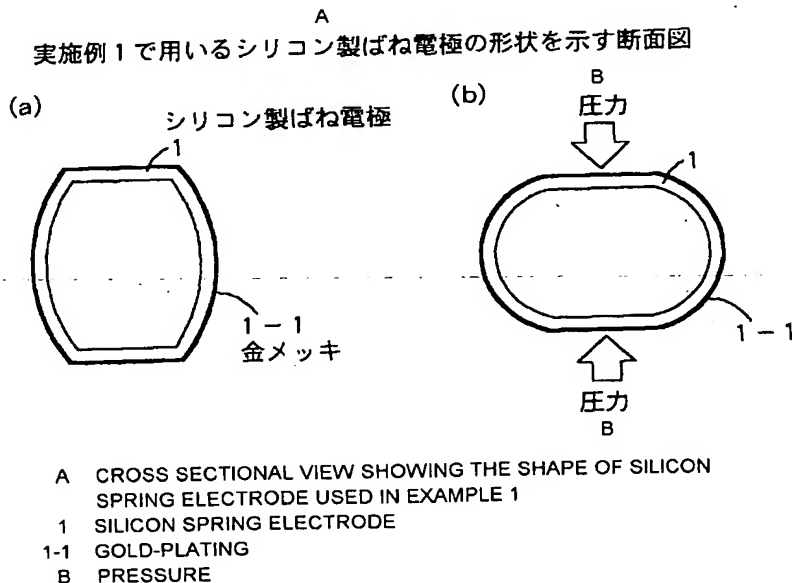
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/055252 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01B 13/00, H01R 11/01 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017783 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 浅田 規裕
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 30 日 (30.11.2004) (ASADA, Norihiro) [JP/JP]; 〒3440115 埼玉県北葛飾
(25) 国際出願の言語: 日本語 郡庄和町米島 3 4 5-1-3 0 8 Saitama (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語 (74) 代理人: 丹羽 宏之, 外 (NIWA, Hiroyuki et al.); 〒
1050004 東京都港区新橋 1 丁目 1 8 番 1 6 号 日本生
(30) 優先権データ: 特願 2003-405851 2003 年 12 月 4 日 (04.12.2003) JP 命新橋ビル 丹羽国際特許事務所 Tokyo (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): マイク
ロプレシジョン株式会社 (MICRO PRECISION CO.
& LTD.) [JP/JP]; 〒1050011 東京都港区芝公園三丁目
1 番 1 4 号 Tokyo (JP). オーキンス エレクトロニクス
カンパニー リミテッド (OKINS ELECTRONICS
CO., LTD.) [KR/KR]; 431060 ギョンギド, アンヤン
-シ, ドンガン-グ, グワンヤン-ドン, 8 2 3, ド
ンギル-テクノタウン, 7 8 0 4 Gyeonggi-do (KR).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
[続葉有])

(54) Title: SILICON SPRING ELECTRODE AND ANISOTROPIC CONDUCTIVE SHEET

(54) 発明の名称: シリコン製ばね電極および異方性導電シート



(57) **Abstract:** Disclosed is an anisotropic conductive sheet which can be applied for finer- and narrower-pitch electrodes. Also disclosed is an electrode used in such an anisotropic conductive sheet. A silicon spring electrode (1) is produced by forming a bending flat spring member out of a single crystal silicon material by anisotropic etching and plating the surface of the flat spring member with gold. The thus-formed spring electrode (1) is fitted and fixed in a through hole formed in a silicon rubber sheet.

[続葉有]